

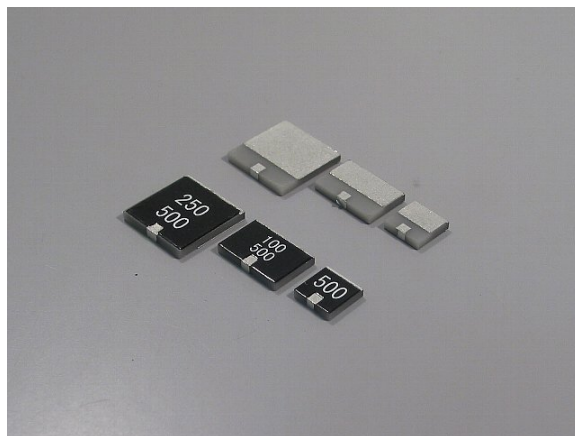
## 高周波 SMD ターミネーション

10W, 50W, 100W, 150W, 250W

## HIGH POWER SMD TERMINATIONS

RFT010, RFT050, RFT100,

RFT150, RFT250



## 特長用途

DC-5GHz 帯の高電力表面実装ターミネーション。

熱伝導の高いセラミック基板を使用し小型で広帯域の製品を提供。ターミネーションの発熱をチップの裏面からあるいは端子から配線板の銅箔に放熱する構造。

基板への金属膜の成膜はスパッタ工程で、はんだ付けによる着膜強度の劣化がきわめて少ない材料構成。

インピーダンスは 50Ω を許容差 1% で標準化。

定格電力は 10W、50W、100W、150W、250W。

移動体固定局通信機、広帯域高周波電力増幅器のアイソレータ終端、その他のターミネーション。

## Features and Applications

High power surface mount termination for all DC up to 5GHz applications.

Small size and wide frequency range specifications realized with through large heat conducting AlN substrate.

Sufficient mechanical strength metallization from spattered thin film technology.

50ohm resistance with tolerance 1% and 10W, 50W, 100W, 150W and 250W provided as standard, and other resistance and power available.

Long life and temperature stability a result of Ni-Cr thin film technology.

Termination for isolator/circulators, fixed station of mobile communication electronics, and high power microwave amplifiers.

## 形名呼称 Ordering Information

Type	Structure	TCR	Resistance	Tolerance	Packaging	Note
RFT100	010	C	500	F	Z01	
RFT010	010	C	500	F	Z00	Bulk
RFT050	020	(50ppm/C)	(50 Ohm)	(1%)	Z01	Tape reel
RFT100						
RFT150						
RFT250						

Structure 010 has not a hot-terminal conductor on the surface of chip side and back.

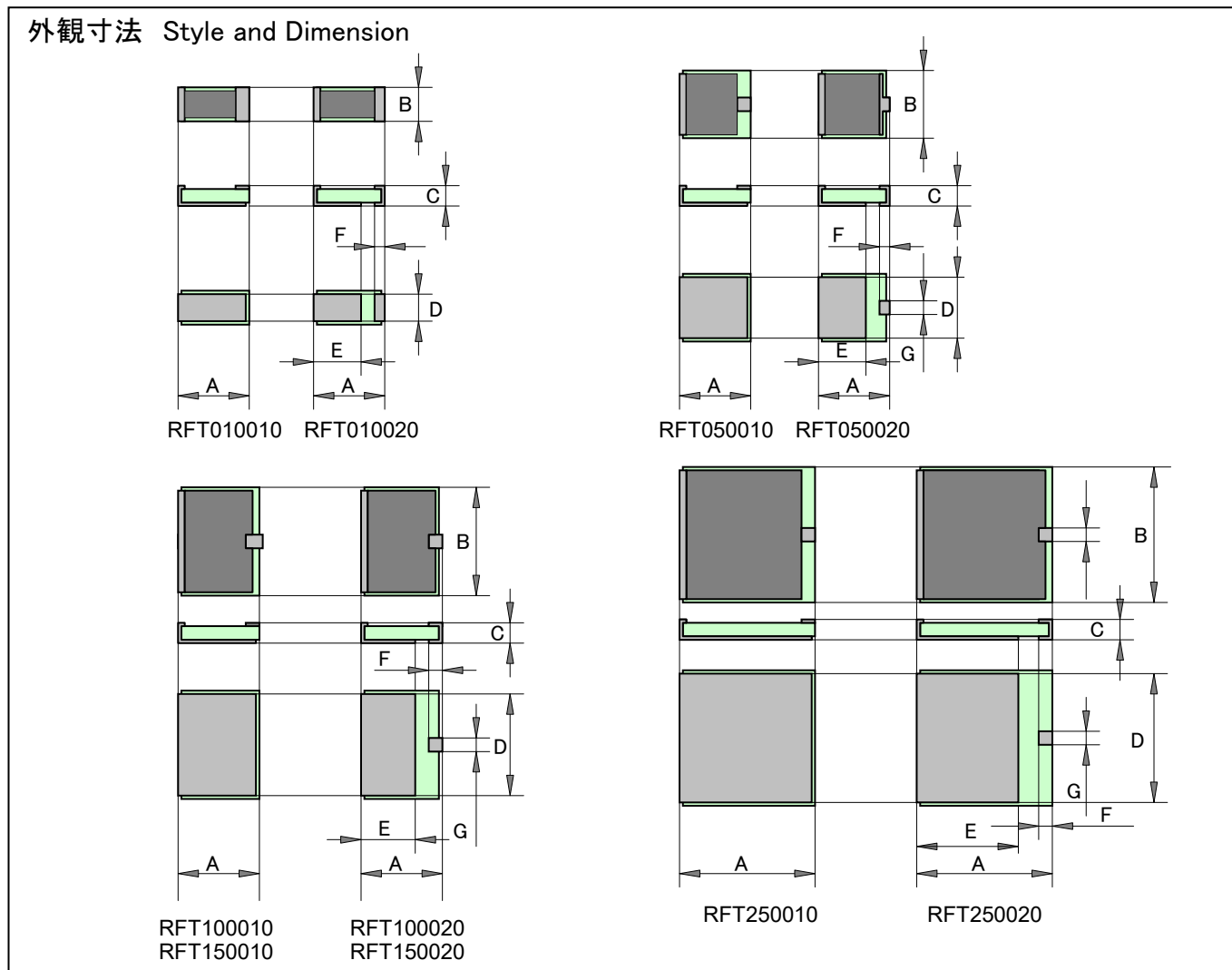
## 仕様性能 Specifications and Performances

Type	RFT010	RFT050	RFT100	RFT150	RFT250	Conditions
Rated Power (W)	10	30	100	150	250	-55 - +100 deg C
Maximum Power (W)	20	50	200	300	500	Pulse < 1 second
Resistance (Std) Ohm	50 Ohms					
TC (ppm/deg C)	50					
Tolerance (%)	1.0					
Heat Resistance (deg C/W)	5.5	1.1	0.5	0.3	0.2	
VSWR at 1GHz	1.15	1.15	1.20	1.20	1.20	
Max Operating Temperature	-55-155 deg C					
Storage Temperature	-55-155 deg C					

高周波用ターミネーション

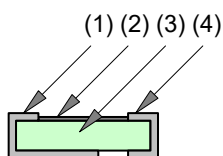
10W, 50W, 100W, 150W, 250W

HIGH POWER SMD TERMINATIONS RFT010, RFT050, RFT100, RFT250



Type	Power	A	B	C	D	E	F	G
RFT010 010	10W	5.08	2.54	1.05	2.34	-	1.27	1.27
RFT010 020		5.08	2.54	1.05	2.30	2.54	1.27	1.27
RFT050 010	50W	5.08	5.08	1.05	4.84	-	1.27	1.27
RFT050 020		5.08	5.08	1.05	4.84	2.54	1.27	1.27
RFT100 010	100W	5.84	8.89	1.05	8.49	-	1.27	1.27
RFT100 020		5.84	8.89	1.05	8.49	3.05	1.27	1.27
RFT150 010	150W	6.35	9.52	1.05	9.12	-	1.27	1.27
RFT150 020		6.35	9.52	1.05	9.12	4.05	1.27	1.27
RFT250 010	250W	9.52	9.52	1.05	9.12	-	1.27	1.27
RFT250 020		9.52	9.52	1.05	9.12	6.98	1.27	1.27

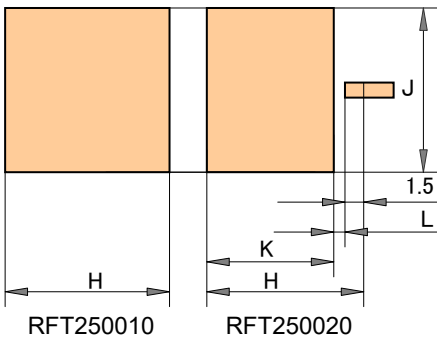
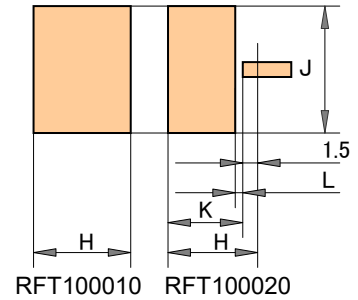
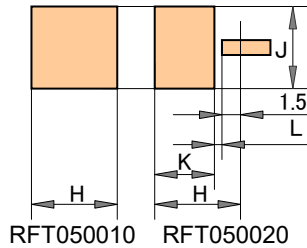
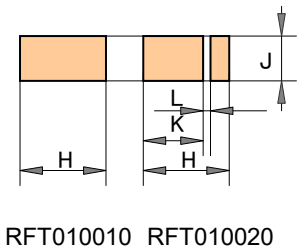
構造・材料 Materials



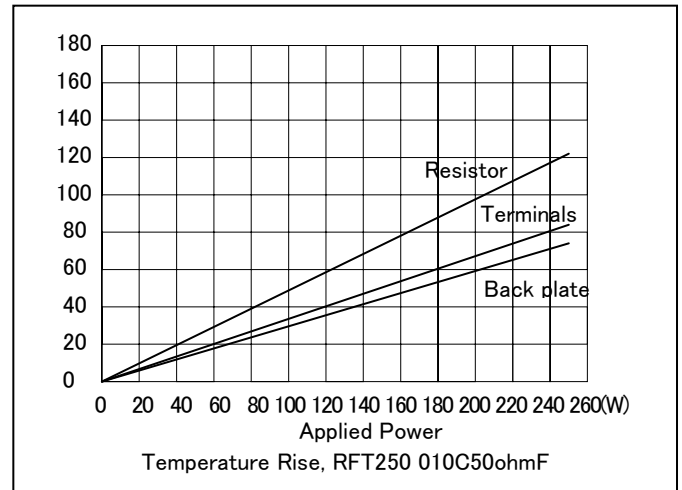
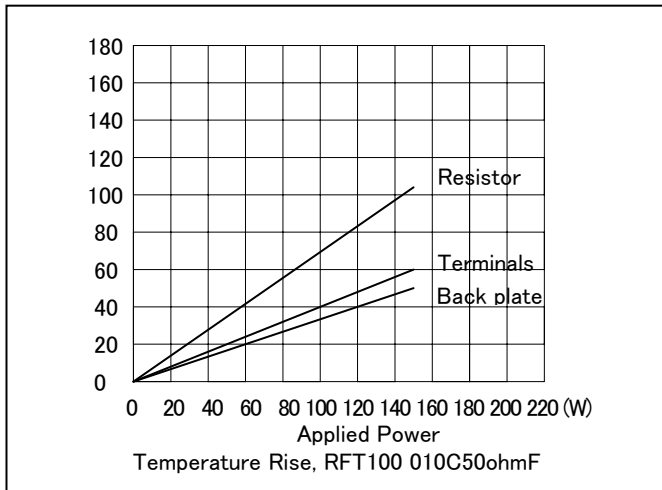
	Substance	Material
(1)	Cold end Terminal	Tin plated Ni + Cu
(2)	Resistive	Ni-Cr
(3)	Substrate	ALN
(4)	Hot end Terminal	Tin plated Ni + Cu

高周波用ターミネーション RFT010, RFT050, RFT100, RFT150, RFT250  
HIGH POWER TERMINATIONS

実装寸法 Foot Pattern Design



	H	J	K	L
RFT010 010	5.48	2.94	-	-
RFT010 020	5.48	2.94	(2.98)	0.5
RFT050 010	5.48	5.48	-	-
RFT050 020	5.48	5.48	(2.98)	0.5
RFT100 010	6.24	9.29	-	-
RFT100 020	6.24	9.29	(3.24)	0.5
RFT150 010	6.75	9.92	--	---
RFT150 020	6.75	9.92	(4.48)	0.5
RFT250 010	9.92	9.92	--	-
RFT250 020	9.92	9.92	(6.92)	0.5



注記:

- (1) 上記以外の抵抗値を製作することができます。工場にお問い合わせください。
- (2) 端子、裏の電極を金属放熱器にはんだ付けしたときの電極温度あるいはフランジ温度によって、定格電力を定義しています。
- (3) RFT の端子、裏の電極をはんだ付けする際の仕上がりはんだ厚みは 50 μm 以下に抑えてください。

Note:

- (1) Other resistance value and substrate thickness are available. Please consult Nikkohm factory.
- (2) Power rating assumes that chip attached on metal plate.
- (3) Solder joint design should assure a solder thickness within 50 micron meters.

負荷軽減曲線 Derating Curve

